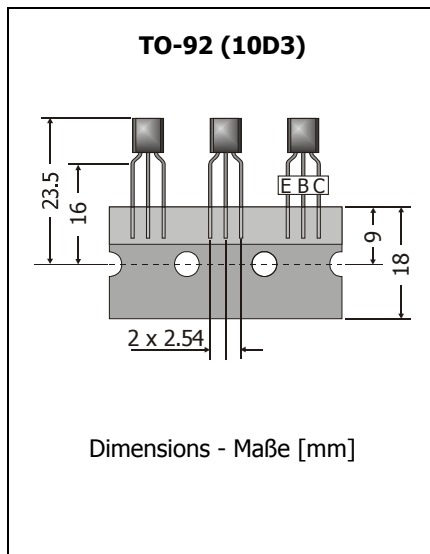


MPSA92
High Voltage PNP Transistors
Hochspannungs-PNP-Transistoren

$I_C = - 500 \text{ mA}$
 $h_{FE} = 25$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

$V_{CE0} = - 300 \text{ V}$
 $P_{tot} = 625 \text{ mW}$

Version 2016-01-04

**Typical Applications**

Signal processing,
Switching, Amplification
Commercial grade ¹⁾

Features

High blocking voltage
High collector current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped in ammo pack 4000
Weight approx. 0.18 g
Case material UL 94V-0
Solder & assembly conditions 260°C/10s
MSL N/A

**Typische Anwendungen**

Signalverarbeitung,
Schalten, Verstärken
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Hohe Sperrspannung
Hoher Kollektorstrom
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet im Ammo-Pack
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings (T_A = 25°C)**Grenzwerte (T_A = 25°C)**

			MPSA92
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V _{CEO}	300 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V _{CBO}	300 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- V _{EBO}	5 V
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	625 mW ²⁾
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- I _C	500 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _s	-55...+150°C

Characteristics (T_j = 25°C)**Kennwerte (T_j = 25°C)**

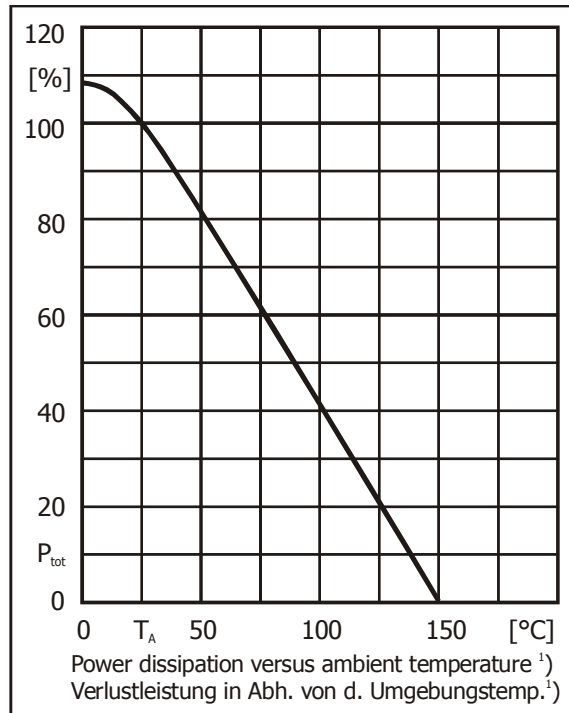
			Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom					
I _E = 0, - V _{CB} = 200 V	MPSA92	- I _{CBO}	–	–	250 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom					
I _B = 0, - V _{EB} = 3 V		- I _{EBO}	–	–	100 nA
Collector saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ³⁾					
- I _C = 20 mA, - I _B = 2 mA	MPSA92	- V _{CEsat}	–	–	500 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ³⁾					
- I _C = 20 mA, - I _B = 2 mA		- V _{BEsat}	–	–	0.9 V

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
- 3 Tested with pulses tp = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen tp = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

Characteristics (T_j = 25°C)

Kennwerte (T_j = 25°C)

		Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾				
- V _{CE} = 10 V, - I _C = 1 mA	h _{FE}	25		
- V _{CE} = 10 V, - I _C = 10 mA	h _{FE}	40		
- V _{CE} = 10 V, - I _C = 30 mA	h _{FE}	25	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
- V _{CE} = 20 V, - I _C = 10 mA, f = 100 MHz	f _T	–	70 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
- V _{CB} = 20 V, - I _E = i _e = 0, f = 1 MHz	MPSA92	C _{CB0}	–	–
				7 pF
Thermal resistance junction – ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R _{thA}	< 200 K/W ²⁾	
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren		MPSA42, MPSA44		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%
 2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden